

Prof. Dr. Jörg P. Kotthaus

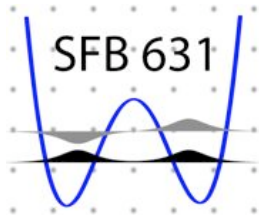
Ludwig \_\_\_\_\_

Maximilians \_\_\_\_\_

Universität \_\_\_\_\_

München \_\_\_\_\_

Sektion Physik und Center for NanoScience, LMU München  
Geschwister-Scholl-Platz 1, 80539 München



**Sonderforschungsbereich 631**



Festkörperbasierte Quanteninformationsverarbeitung

Department für Physik  
der Ludwig-Maximilians-Universität  
Geschwister-Scholl-Platz 1, 80539 München  
Seminarraum im Altbau ( **Raum N 110** )

**Datum:** Montag, den 07.12.2009

**Uhrzeit:** 13.30 Uhr

**Vortragender:** Gregor Koblmüller  
Lehrstuhl für Experimentelle Halbleiter-  
physik I (E24) Experimentalphysik,  
Walter Schottky Institut, TU München

**Titel:** „Defect Structure and Electronic Properties  
in High Electron Mobility III-V Semiconduc-  
tor Materials: from Bulk to Nanostructures”